

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

平4-96343

⑫ Int. Cl.

H 01 L 21/88  
21/60

識別記号

3 0 1

E  
P

庁内整理番号

7013-4M  
6918-4M

⑬ 公開 平成4年(1992)3月27日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑭ 発明の名称 半導体装置

⑮ 特 願 平2-213851

⑯ 出 願 平2(1990)8月13日

⑰ 発 明 者 堀 田 信 昭  
⑱ 出 願 人 日本電気株式会社  
⑲ 代 理 人 弁理士 内 原 晋

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内  
東京都港区芝5丁目7番1号

明 細 書

発明の名称

半導体装置

特許請求の範囲

リダゲンゲンシ回路ブロックを有し半導体チップ表面にワイヤーボンディング用パッドを有する半導体装置において、前記ワイヤーボンディング用パッドに電気的に接続する電気的測定用パッドをウェーハ表面に有することを特徴とする半導体装置。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体装置に関し、特にリダゲンゲンシ回路ブロックを含む半導体ウェーハのパッドレイアウト構造に関する。

従来、半導体装置のパッドレイアウト構造は、第3図に示すようなものとなっていた。

即ち、半導体チップ20の四辺にワイヤーボンディングに都合のいいようなある間隔を有してパッド31が並んでおり、それらは又、ウェーハ状態でのチップの電気的測定をも兼ねるものであった。

これは、リダゲンゲンシ回路ブロックを有するような半導体装置でも例外ではなかった。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の半導体装置では、リダゲンゲンシ回路ブロックのリダゲンゲンシ測定による良品半導体チップを選択する第1の電気的測定と、レーザーによるヒューズカット法によりリダゲンゲンシ良品チップの良品チップへの復活後に、最終的な良品又は不良品チップの判定を行う為の第2の電気的測定がウェーハ状の同一の電気的測定用パッド上でプローブを用いて行なわれた後、良品の半導体チップは上記パッド上にワイヤーボンディングされて各種ケースに組立てられる。

従ってボンディングパッドはプローブで2度アタックされた後に使用される為、組立時のボンデ

ィング不良になったり、時にはワイヤから伝わって侵入する水分の為にパッドコロージョンを発生させたりするという欠点があった。

(問題を解決するための手段)

本発明の半導体装置は、リダグンデンシ回路ブロックを有し半導体チップ表面にワイヤーボンディング用パッドを有する半導体装置において、前記ワイヤーボンディング用パッドに電気的に接続する電気的測定用パッドをウェーハ表面に有して構成されている。

(実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明する。

第1図は本発明の第1の実施例のボンディングパッドのレイアウトを示す平面図である。

半導体チップ10上のボンディング用パッド11の大きさは一辺が約100 $\mu$ mであり、ウェーハ上での電気的測定用パッド12の大きさは一辺が約50 $\mu$ mである。

ボンディングパッド11と測定用パッド12を

本実施例では、測定用パッド22がクスライブライン上に形成されている為、パッド数の増加による半導体チップ面積の増加を招かないという利点がある。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、リダグンデンシ回路ブロックなどを有する半導体装置において、ワイヤーボンディング用パッドとは別に、リダグンデンシを含むウェーハ上での電気的測定用パッドを有することにより、電気的測定時にリダグンデンシ用も含めてプローブで少なくとも2度アタックされたパッドをボンディング用としては使わないで済む為、組立時のボンディング歩留が向上したり、ワイヤから伝わって侵入する水分によるパッドコロージョンに対して耐性を大きくできるという効果がある。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例のパッドレイアウトを示す平面図、第2図は本発明の第2の実施

例のボンディングパッドのレイアウトを示す平面図である。これら導電層11、12、13はいずれもアルミニウムで形成されている。

以上のような半導体チップ構成においてウェーハ上での電気的測定は、リダグンデンシ回の測定も含めて測定用パッド12を用いて行ない、ワイヤーボンディングはボンディング用パッド11を用いて行なう。従って各パッドのアタックは、各一度となる。

第2図は本発明の第2の実施例のボンディングパッドのレイアウトを示す平面図である。

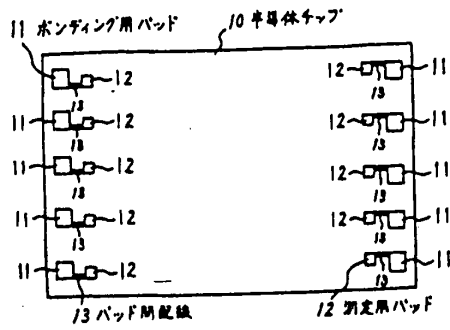
半導体チップ20上のボンディング用パッド21の大きさは一辺が約100 $\mu$ mであり、ウェーハ上での電気的測定用パッド22の大きさは一辺が約50 $\mu$ mである。

ボンディング用パッド31と測定用パッド32を接続する為の配線23の巾は約10 $\mu$ mである。31、32、33はいずれもアルミニウムで構成されており、その動作は実施例1と同様である。

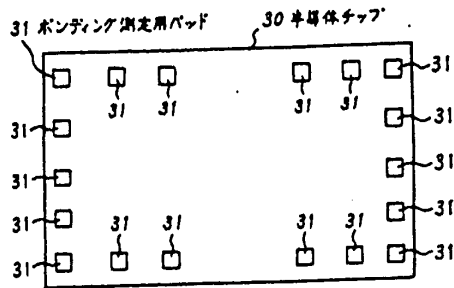
例のパッドレイアウトを示す平面図、第3図は従来の半導体装置の一例のパッドレイアウトを示す平面図である。

10、20、30…半導体チップ、11、21…ボンディング用パッド、12、22…ウェーハ上での電気的測定用パッド、13、23…パッド間配線、21…ボンディング測定用パッド。

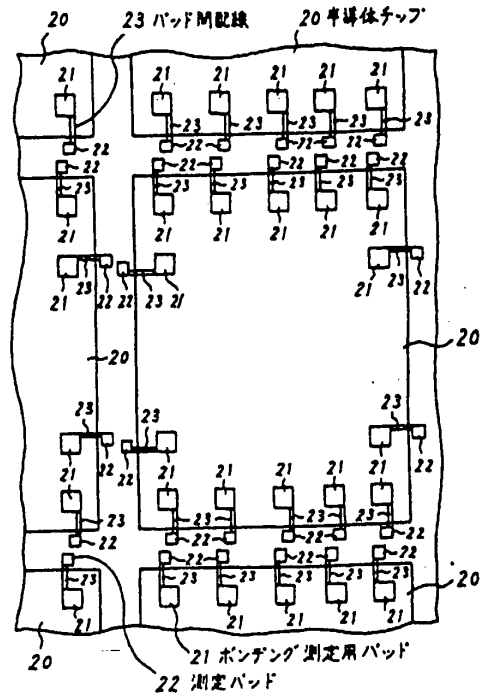
代理人 弁理士 内 原 晋



第1図



第3図



第2図

BEST AVAILABLE COPY